

No.1630
6284

STK 0100

厚膜混成集積回路
100W min AF パワーアンプ出力段(DPP)

◇ 半導体ニュース No.622 と同一です。

特長 ・ 2 電源 1 チャンネル分内蔵。

- ・ ダーリントン構成、純コンプリメンタリ回路を採用。
- ・ 同一シリーズでは同一パッケージ、同一ピン配置のため 外付けプリント基板の標準化が可能。
- ・ 温度補償回路が内蔵され 金属板による熱的帰還がよく また きわめて熱的安定性に優れている。
- ・ 電圧増幅等の回路設計の自由度が高くなるため 音質設計が可能。

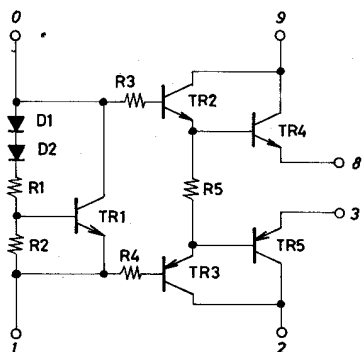
最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$		unit
最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$	± 75 V
最大コレクタ電流	$I_C \text{ max}$	12 A
熱抵抗	θ_{j-c} 理想放熱	1.1 $^\circ\text{C}/\text{W}$
接合部温度	T_j	150 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	$-30 \sim +105$ $^\circ\text{C}$

推奨動作条件 / $T_a = 25^\circ\text{C}$		unit
推奨電源電圧	V_{CC}	± 50 V
負荷抵抗	R_L	8 Ω

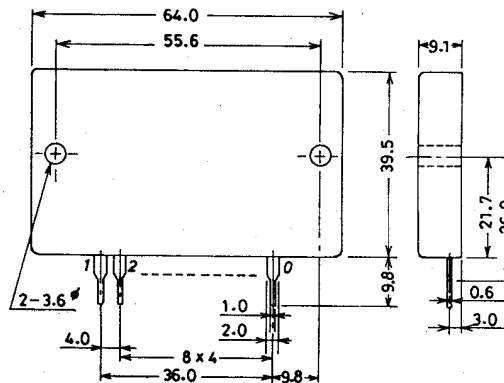
動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = \pm 50\text{V}$, $R_L = 8\Omega$, $R_g = 600\Omega$, $V_G = 40\text{dB}$, 指定測定回路による。

		min	typ	max	unit
無信号電流	I_{CCO} $V_{CC} = \pm 60$		40	80	mA
出力電力	P_o THD=0.1%, $f=20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$	100			W
全高調波ひずみ率	THD (1) $P_o = 1 \sim 100\text{W}$, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$			0.1	%
	THD (2) $P_o = 1\text{W}$, $f = 1\text{kHz}$		0.02		%

等価回路



外形図 4006
(unit: mm)



* これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370-05 群馬県大泉町坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL 0276-63-2111 (大代表)

6284Y0寿 5-1736 No.1630-1/2